

产品简介

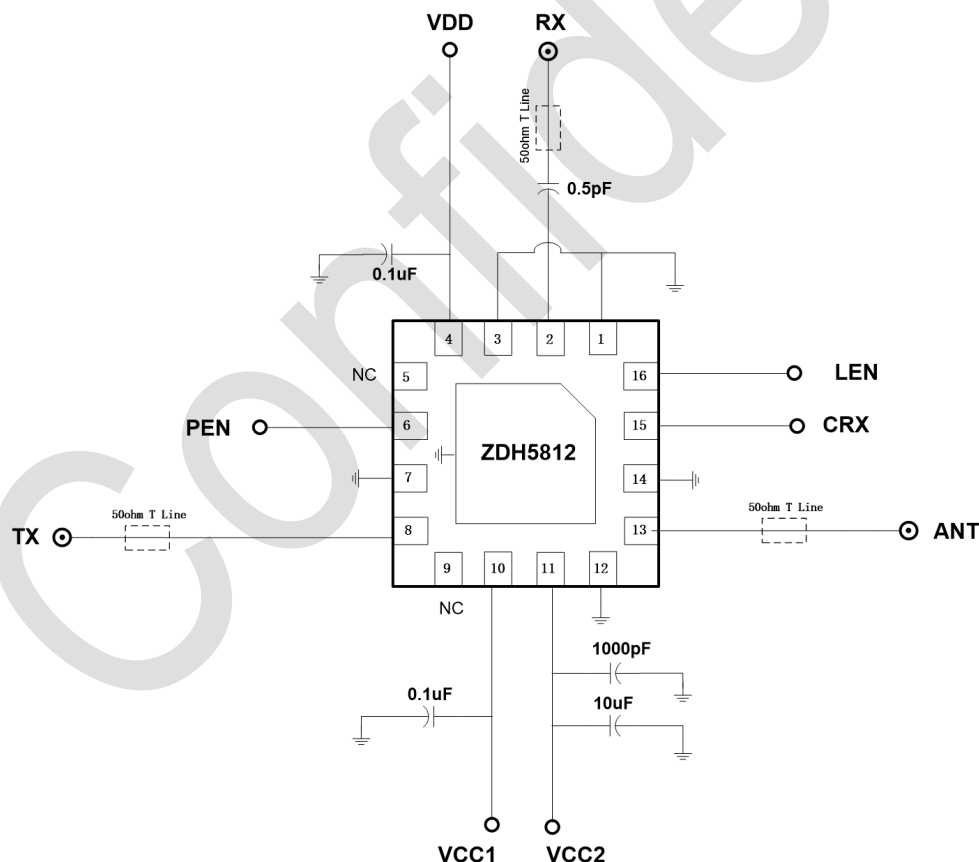
ZDH5812 是一款单芯片全集成的 5GHz 射频前端芯片 (RF Front-end IC)。它集成了功放 (PA)、可旁路低噪声放大器 (LNA with Bypass) 和射频开关 (SW)。采用典型 5V 供电, 输入、输出阻抗已经内部匹配到 50Ω, 外围应用电路简洁。

ZDH5812 采用标准绿色无铅 QFN3x3-16 封装, 具有很好的可靠性、经济性和极高的性价比。

建议工作条件

参数	最小值	典型值	最大值	单位
带宽	4900	-	5850	MHz
存储温度	-65	-	150	°C
工作温度	-55	-	125	°C
工作电压	4.0	5.0	5.5	V
TX 输入功率	-	10	-	dBm
ANT 输出功率	-	5	-	dBm

典型应用电路



典型参数

TX 参数 ⁽¹⁾	条件	数值			单位
频率	-	4900	5500	5850	MHz
Psat	3% EVM	21	22	22	dBm
Gain	-	32	32	34	dB
S11	-	-6	-8	-12	dB
S22	-	-15	-15	-18	dB
Ic	无 RF 输入信号	235			mA
Time	50% TX_EN to 90/10% RF	100			ns

RX 参数 ⁽²⁾	条件	数值			单位
频率	-	4900	5500	5850	MHz
Gain	-	12	12	12	dB
S11	-	-8	-10	-14	dB
S22	-	-13	-10	-11	dB
NF	-	2.2	2.3	2.5	dB
IDDQ	无 RF 输入信号	17			mA
Time	50% RX_EN to 90/10% RF	100			ns

注: (1) 条件: VCC= +5V, PEN=1.8V, LEN=CRX=0V;

(2) 条件: VDD=+5V, PEN=0V, LEN=CRX=1.8V。